科学研究費助成事業

平成 2 8 年 5 月 3 0 日現在

研究成果報告書

機関番号: 12601 研究種目: 基盤研究(C)(一般) 研究期間: 2013~2015 課題番号: 25390075 研究課題名(和文)スピン偏極水素原子ビームによる表面磁気秩序の解明

研究課題名(英文)Elucidation of surface magnetic ordering by a spin-polarized atomic hydrogen beam

研究代表者

小倉 正平(Ogura, Shohei)

東京大学・生産技術研究所・助教

研究者番号:10396905

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円

研究成果の概要(和文):本研究ではスピン偏極水素原子ビームを利用してAg(111)上の物理吸着酸素分子層の表面磁 気秩序を明らかにすることを目的とした.水素分子ビームの高強度化,磁石や質量分析器の位置制御機構の作成,多光 子共鳴イオン化法による水素分子ビームの速度測定,水素分子ビームの散乱角度分解測定などを行った.水素原子ビー ムの強度が低く,目的としていた表面磁気秩序の解明までには至らなかったが,個々の部分については本研究により完 成したので今後水素原子ビームの高強度化ができれば上記の目的を達成できると考える.

研究成果の概要(英文): In the present study, we investigated the surface magnetic ordering of a molecular oxygen layer adsorbed on Ag(111) by using a spin-polarized atomic hydrogen beam. We optimized the flux of the molecular hydrogen beam and created positioning devices of the magnets and mass spectrometer. We also measured the velocity of the molecular hydrogen beam and angular distributions of the scattered molecular hydrogen beam from surfaces by resonance-enhanced multi-photon ionization. Although we could not measure the surface magnetic ordering due to a lower flux of the atomic hydrogen beam, the development of the necessary parts was accomplished and we think that the surface magnetic ordering can be investigated if the flux of the atomic hydrogen beam is increased further.

研究分野:表面界面物性

キーワード: 水素 スピン偏極 磁性 表面・界面物性

1.研究開始当初の背景

酸素分子はスピン1を持つ磁性分子である. 金属表面では吸着とともに金属電子との混 成により通常スピンは消失する.しかし最近 我々は水素分子のオルト・パラ転換研究を通 じて,酸素分子は低温でスピンを保持したま ま Ag(111)表面に物理吸着することを見出し た.低速電子線回折により Ag(111)表面に物 理吸着した酸素分子の吸着構造が測定され, 被覆率によって図1のような2種類の吸着構 造を示すことが報告された.低被覆率では分 子軸を表面平行にしてスピンは反強磁性的 に配列し,高被覆率では分子軸を垂直にして スピンは 120°構造を取るというものである. 一方,理論計算によると被覆率によっては強 磁性的な振る舞いをすることが予測されて おり、また極低温では近藤効果によりスピン が消失する可能性も示唆されている.しかし 現在のところ表面磁性を調べるプローブが なく,酸素分子の表面磁気秩序については未 解明となっている.我々はこれまで六極磁石 を用いたスピン偏極水素原子ビームの開発 を行っており,マイクロ波放電により水素分 子を解離させ、水素分子の解離率、ビームの 強度と放出角度分布などを測定してきた.電 子スピン偏極した水素原子ビームを表面に 入射し, 散乱後のスピン偏極率の変化を測定 すれば,その緩和時間から表面磁気秩序を解 明できると考えられる.



図1. Ag(111)表面の酸素分子の吸着構造.

2.研究の目的

本研究ではスピン偏極水素原子ビームを 利用して Ag(111)上の物理吸着酸素分子層の 表面磁気秩序を明らかにすることを目的と する.本研究では現有のスピン偏極水素原子 ビームにスピン選別のためのシュテルン・ゲ ルラッハ(SG)磁石を作成して組み合わせ,可 動の四重極質量分析器(QMS)によりスピン偏 極率の測定を行う.またスキマーとビームス トッパーを追加してビームの最適化を行う. さらに現有の超高真空装置と組み合わせ, Ag(111)表面に物理吸着した酸素分子層にス ピン偏極水素原子ビームを入射し,散乱後の スピン偏極率の変化を SG 磁石と QMS により 測定する.また現有の外部磁場印加装置を用 いて,入射水素原子ビームのスピンの試料表 面に対する方向を制御してスピン偏極率の 変化を測定することにより , 酸素分子のスピ ンの方向を解明する.得られた実験結果をも とに解析を行い,表面磁気秩序の解明を行う。 Ag(111)表面の物理吸着酸素分子層の表面磁

気秩序の解明ができれば,この系にとどまら ず広く表面磁性のプローブとしての応用が 期待できる.

- 3.研究の方法
- (1) SG 磁石の作成

現有のスピン偏極水素原子ビーム源にス ピン偏極率の測定を行うために SG 磁石を作 成して組み合わせる,図2に実験装置の概略 図を示す.2.45 GHz のマイクロ波放電により 生成した水素原子を石英管を通して真空槽 に導入し,その水素原子ビームを六極磁石に よりスピン偏極させる. 六極磁石は中心から の距離の2 乗に磁束密度が比例する磁石で, この内部を通ると負の磁気モーメントを持 った水素原子は収束され,正の磁気モーメン トを持った水素原子は発散する、十分強い磁 場中では水素原子の磁気モーメントの値は ± μ_в (ボーア磁子)となり,これにより- μ_в を持った電子スピン偏極水素原子ビームが 得られる.スピン偏極率は SG 磁石によりス ピンを分離し,可動のQMSを用いて各成分の 流量を測定することにより求める. 散乱実験 ではスピン偏極水素原子ビームの収束位置 に試料を置き,散乱してくるビームの各スピ ン成分を SG 磁石により分離し QMS で測定す ることによりスピン偏極率を求める. 六極磁 石は磁極長 60 mm 磁極先端磁束密度 0.65 T, ボア径 5 mm で, SG 磁石は磁極長 80 mm, 磁 極先端磁束密度 0.7 T,磁極間距離 5.8 mm で ある.水素原子ビームの速度分布を考慮する と QMS 位置でのスピン偏極率は約 95%, ビー ムの分離は約8mmと計算され,収束効果に よりビーム強度が大きくなるのでアパチャ ーを取り付けた QMS で十分スピン偏極率が測 定可能である.SG磁石は超高真空中での使用 のためにベーキング可能な永久磁石で作製 し,磁石の固定には接着剤は使用せず,ガス 発生を抑えるために磁石を Ni メッキする. 軸あわせの精度がビーム強度を左右するの で, 六極磁石と SG 磁石の位置調整機構を作 成する.また測定感度を上げるため,スキマ ーを追加しビームの高強度化を行う.



図2.スピン偏極水素原子ビームの概略図.

(2) スピン偏極率の測定

SG 磁石を図 2 のように配置し,可動式の QMS により分離されたビームの強度を測定し, スピン偏極率を求める.また六極磁石の直後 に+µ。成分のビームを除去するビームスト ッパーを置き,スピン偏極率とビーム強度の 変化を測定する.計算結果との比較をしなが ら,ビームの最適化を行う.

(3) 散乱によるスピン偏極率変化の測定 現有の超高真空槽とスピン偏極水素原子 ビームを組み合わせ,Ag(111)表面に物理吸 着した酸素分子層で散乱した水素原子のス ピン偏極率変化の測定を行う. ビームの収束 位置に準備した Ag(111)表面上の物理吸着酸 素分子層にスピン偏極水素原子ビームを照 射し,散乱後のスピン偏極率の変化を測定す る,表面の磁場が均一な場合ではスピン反転 は起こらず,不均一な磁場があればスピン反 転が起こると考えられる.酸素分子のスピン の向きは吸着量が低い場合は表面垂直で,吸 着量が高い場合は表面平行になることが予 測されており,水素原子の表面に対するスピ ンの向きによりスピン偏極率の変化に違い があると考えられるので,試料まわりに外部 磁場を印加することにより水素原子のスピ ンの向きを制御し,その違いを調べる.また 基板温度や吸着量により酸素分子の吸着構 造が変わるので,それらを変化させた測定も 行う.水素原子ビームの強度が低く散乱後の スピン偏極率の測定が困難な場合は,表面に おける水素分子生成率を QMS によって測定す ることによりスピン反転時間を求めること も試みる.

(4) 表面磁気秩序の解明

得られた実験結果をもとに磁気双極子相 互作用を考慮したスピン反転のモデルを構 築し,Ag(111)表面上の物理吸着酸素分子層 の磁気秩序を明らかにする.

4.研究成果

(1) SG 磁石の作成とビーム強度の最適化

スピン偏極水素ビームを散乱実験のため の超高真空槽と組み合わせ,スピン偏極水素 原子ビームの高強度化と、SG磁石とQMSの位 置制御機構の作成を行った.スキマーを作成 しビームノズルの直後に設置し,超高真空槽 において QMS によりビーム強度を測定し,ス キマーとビームノズルとの距離を変化させ てビーム強度の最適化を行った.QMS の信号 強度と試料位置に設置したビームストッパ -の有無による圧力変化からビーム強度を 見積もり、スキマーの導入により試料位置で のビーム強度が単位時間あたり 10¹³ cm⁻²から 10¹⁴ cm⁻²へと約 10 倍増加することがわかった. さらに超高真空槽のビーム照射時のバック グラウンド圧力もよくなり , 信号雑音比が向 上しより感度の高い測定ができる状態とな った.さらにSG磁石については4軸,QMSに ついては2軸の位置制御機構を作成し,スピ ン偏極率の測定が可能な状態となった、一方、 スキマーの導入によりスピン偏極のための 六極磁石と SG 磁石の設置位置の変更が必要 となったため、真空系の再設計を行った、

(2) 水素分子ビームの速度測定

ビームの高強度化のために導入したスキ マーにより水素ビームの速度が変化し, 六極 磁石と SG 磁石の位置変更が必要になる可能 性があるため,多光子共鳴イオン化法により 水素ビームの速度測定を行った.水素ビーム 下流にレーザー用の窓を設置し,水素分子ビ ームに対して対向する方向からレーザーを 照射し,レーザーの波長に対するイオン化強 度スペクトルを測定したところ,図3に示す ように真空槽全体に水素分子を満たした場 合に比べてドップラー効果によりピーク位 置の波長が約0.0012 nmシフトした.このシ フト量から水素ビームの速度を約1800 m s⁻¹ と見積もった.



図 3. 多光子共鳴イオン化法による水素分子ビー ムの速度測定.

(3) 散乱角度分布の測定

散乱実験に必要な試料ホルダーや角度分 解のためのアパチャーなどの真空部品を作 成し,水素分子ビームで散乱角度分布の測定 を行った.清浄な TiO₂(110)表面に水素分子 ビームを入射し,試料のビームに対する角度 を変えながら散乱してくる水素分子ビーム の強度を多光子共鳴イオン化法により測定 した.図4に示すように鏡面反射の角度であ る 45°にピークを持つ散乱角度分布が得ら れ,水素分子ビームによる散乱角度分布が測 定できることが確認できた.



図 4. TiO₂(110)表面における水素分子ビームの散 乱角度分布.

(4) 水素原子ビームの強度測定

ビーム高強度化のためのスキマーの導入 に伴いこれまでとは形状の異なる石英管を 作成したため,水素分子の解離率がこれまで

の値より減少した.そのため水素原子を効率 よく測定できるクロスビームイオン源の四 重極質量分析器(QMS)を導入し,水素分子・ 原子ビームの強度の見積もりを行った.図5 に示すように水素分子ビーム入射時の QMS の 信号と,真空槽中に水素分子を満たした場合 のQMSの信号の差からビームのみの強度を調 べ,水素分子の石英管入口の圧力に比例して 単位時間あたり 10 の 12~14 乗個の水素分子 入射数と見積もった,さらにマイクロ波の有 無による質量数2のQMS 信号の差から水素分 子の解離率を 0.13 と見積もった.水素原子 ビームの速度を測定するためのレーザーや 光学系を準備したが,水素原子ビームの強度 が低く,測定までには至らなかった.石英管 の形状や冷却法が変わったため,マイクロ波 の放電により石英管が高温となり、再結合率 が上がったのが原因だと考えられる.



図 5. QMS 位置の圧力 Pa に対するビーム入射時 (Beam)とH₂雰囲気中(VLV)でのQMS 信号強度.

研究期間全体としては水素分子ビームの 高強度化 磁石や QMS の位置制御機構の作成 . 多光子共鳴イオン化法による水素分子ビ-ムの速度測定,水素ビームの散乱角度分解測 定などを行った.しかし水素原子ビームの高 強度化がうまくいかず,目的としていた Ag(111)上の物理吸着酸素分子層の表面磁気 秩序の解明までには至らなかった.個々の部 分については本研究によりほぼ完成したの で今後水素原子ビームの高強度化ができれ ば本来の目的を達成できると考える.

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計9件)

G. S. Grigorkina, I. V. Tvauri, A. G. Kaloeva, O. G. Burdzieva, D. Sekiba, S. Ogura, K. Fukutani, T. T. Magkoev, Reduction of nitric oxide with carbon monoxide on the Al-Mo(110) surface alloy, Solid State Communications, 查読有, 233, 11-14, 2016,

DOI: 10.1016/j.ssc.2016.02.010

S. Ogura, M. Okada, K. Fukutani,

Complete H-D exchange of butene via D absorbed in a Pd-Au alloy, Journal of Physical Chemistry C, 査読有, 119, 23973-23977, 2015 DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b07216

T. Suzuki, J. Konishi, K. Yamamoto, <u>S.</u> K. Fukutani, IR practical Oqura. extinction coefficients of water in alkali lime silicate glasses determined by nuclear reaction analysis, Journal of the American Ceramic Society, 査読有, 98, 1794-1798, 2015 10.1111/jace.13568

K. Fukada, M. Matsumoto, K. Takeyasu, S. Ogura, K. Fukutani, Effects of hydrogen on the localized electronic states and electronic conductivity of rutile $TiO_2(110)$, Journal of the Physical Society of Japan, 査読有, 84, 064716, 2015 DOI: 10.7566/JPSJ.84.064716

鈴木俊夫,小西順子,山本清,小倉正平 <u>福谷克之</u>,ガラス中水分定量のための核反 応分析,分析化学,查読有,63,831-836, 2014

DOI: 10.2116/bunsekikagaku.63.831

K. Takeyasu, K. Fukada, S. Ogura, M. Matsumoto, K. Fukutani, Two charged states of hydrogen on SrTiO₃(001) surface, Journal of Chemical Physics, 査読有, 140, 084703, 2014 DOI: 10.1063/1.4866645

K. Takeyasu, K. Fukada, S. Ogura, M. Matsumoto, K. Fukutani, Electronic structure of the $SrTiO_3(001)$ surfaces: effects of the oxygen vacancy and hydrogen adsorption, Applied Science and Convergence Technology, 査読有, 23, 201-210, 2014 DOI: 10.5757/ASCT.2014.23.5.201

T. Suzuki, J. Konishi, K. Yamamoto, S. K. Fukutani, Practical IR Ogura, extinction coefficients of water in soda lime aluminosilicate glasses determined by nuclear reaction analysis, Journal of Non-Crystalline Solids, 査読有, 382, 66-69, 2013

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2013.10.011

S. Ogura, M. Okada, K. Fukutani, Near-surface accumulation of hydrogen and CO blocking effects on a Pd-Au alloy, Journal of Physical Chemistry C, 查読有, 117, 9366-9371, 2013 DOI: 10.1021/jp402317h

[学会発表](計13件)

<u>小倉正平</u>,<u>福谷克之</u>,Pd₇₀Au₃₀(110)の水素 放出に対する CO キャップ効果の TDS シミュ レーション,日本物理学会第 71 回年次大会, 東北学院大学(宮城県仙台市),2016 年 3 月 21 日

小<u>倉正平</u>, Markus Wilde, <u>福谷克之</u>,共 鳴核反応法による水素の時空間分解測定, 第 18 回 AMS シンポジウム,東京大学(東京 都文京区), 2016 年 3 月 4 日

小倉正平,岡田美智雄,福谷克之, Dynamic C0 cap effects on hydrogen transport across the Pd₇₀Au₃₀(110) surface,表面・界 面スペクトロスコピー2015, 国立女性教育 会館 (埼玉県比企郡), 2015 年 11 月 27 日

小倉正平,岡田美智雄,福谷克之, Pd₇₀Au₃₀(110)表面での水素吸放出に対する動 的分子キャップ効果,日本物理学会秋季大会, 関西大学(大阪府吹田市), 2015年9月16 日

小倉正平,岡田美智雄,<u>福谷克之</u>, Pd₇₀Au₃₀(110)表面におけるNOの吸着構造,日 本物理学会第70回年次大会,早稲田大学 (東京都新宿区),2015年3月21日

<u>S. Ogura</u>, M. Okada, <u>K. Fukutani</u>, Elucidation of CO blocking effect on a Pd-Au alloy, 7th International Symposium on Surface Science, Japan (Shimane), 4 November 2014

小倉正平, AuPd 合金表面での水素吸収と 分子キャップ効果,同位体置換反応(招待講 演),第12回水素量子アトミクス研究会,東 北大学(宮城県仙台市),2014年10月24日

小倉正平,岡田美智雄,<u>福谷克之</u>, Pd₇₀Au₃₀(110)表面におけるCOキャップ構造の 解明,日本物理学会秋季大会,中部大学(愛 知県春日井市),2014年9月8日

<u>小倉正平</u>,岡田美智雄,<u>福谷克之</u>,PdAu 合金表面の水素吸放出における CO キャップ 効果の解明,真空・表面学術合同講演会, つくば国際会議場(茨城県つくば市),2013年 11月27日

小倉正平,岡田美智雄,I. Pletikosić, P. Pervan, M. Milun, <u>福谷克之</u>, Pd₇₀Au₃₀(110) 表面の電子状態,日本物理学会秋季大会, 徳島大学(徳島県徳島市), 2013 年 9 月 26 日

<u>S. Ogura</u>, M. Okada, <u>K. Fukutani</u>, Hydrogen in a Pd-Au alloy: CO blocking effects and H-D exchange reaction, 1st Hayashi Conference, Japan (Hayama), 17 July 2013

小倉正平,表面科学におけるガス放出測 定(招待講演),日本真空学会7月研究例会, 機械振興会館(東京都港区),2013年7月3日

<u>S. Ogura</u>, M. Okada, <u>K. Fukutani</u>, Subsurface accumulation of hydrogen and CO blocking effects on a Pd-Au alloy (招待 講演), 9th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Spain (Madrid), 25 June 2013

〔その他〕 ホームページ等 http://oflab.iis.u-tokyo.ac.jp/

6.研究組織
(1)研究代表者
小倉 正平(OGURA SHOHEI)
東京大学・生産技術研究所・助教
研究者番号:10396905

(2)連携研究者
福谷 克之(FUKUTANI KATSUYUKI)
東京大学・生産技術研究所・教授
研究者番号:10228900